

## SD 451 ... SD 460

Komplementäre 10 A-npn- und pnp-Epibasis-Darlington-Transistoren.

Sie sind robust gegenüber dem 2. Durchbruch, so daß die maximal zulässige Verlustleistung im SOAR-Diagramm erst bei relativ hohen Kollektor-Emitter-Spannungen reduziert werden muß.

Weiterhin besitzen die Bauelemente große Gleichstromverstärkungswerte ( $h_{21E}$ ). Diese Bauelemente sind für den Einsatz als Leistungsschalt-, Regel- und Verstärkertransistoren im NF-Bereich vorgesehen.

Bauform 8

### Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung	$ U_{CEO} $	45/60/80/100/120	V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung	$ U_{CBO} $	45/60/80/100/120	V
Emitter-Basis-Durchbruchspannung	$ U_{EBO} $	5	V
Kollektordauerstrom	$ I_C $	10	A
Kollektorspitzenstrom	$ I_C $	15	A
Basisstrom	$ I_B $	250	mA
Basisspitzenstrom	$ I_B $	300	mA
Gesamtverlustleistung $\vartheta_a \leq 25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	90	W
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_j$	150	$^\circ\text{C}$

### Kennwerte

		min.	max.
Kollektor-Basis-Reststrom $ U_{CB}  =  U_{CBO_{max}} $	$ I_{CBO} $		0,2 mA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $ I_C  = 3\text{ A};  I_B  = 12\text{ mA}$	$ U_{CE_{sat}} $		0,2 V
Gleichstromverstärkung $ I_C  = 3\text{ A};  I_B  = 3\text{ V}$	$h_{21E}$	1 000	